DATENBLATT

TSIC™ Digitale Halbleitertemperatursensoren TSIC 206 / 306



Beschreibung



Technische Daten

Digitale Temperatursensoren						
Messbereich	-50 +150 °C					
Anschluss	Digitaler Anschluss	, 11 Bit				
Genauigkeit	TSic 206	±0,5 K				
(im Bereich 10 90 °C)	TSic 306	±0,3 K				
Auflösung	0,1 K					
Messrate	10 Hz					
Betriebsspannung	2,97 5,5 V					
Betriebsstrom	< 80 µA bei 25 °C					
(bei 3,3 V)	(30 80 µA)					
Last am Ausgang	$R_L > 10 \text{ kOhm}$					
	C _L < 10 nF					
V _{DD} Kondensator	80 470 nF					
Gehäuse	3-pin TO92 (bedrah 8-pin SO8 (SMD)	itet) oder				

Artikelnummer	
Digitaler Halbleiter-Temperatursensor TSIC206, TO92-Gehäuse	TSIC206-TO92
Digitaler Halbleiter-Temperatursensor TSIC206, S08-Gehäuse	TSIC206-S08
Digitaler Halbleiter-Temperatursensor TSIC306, TO92-Gehäuse	TSIC306-TO92
Digitaler Halbleiter-Temperatursensor TSIC306, S08-Gehäuse	TSIC306-S08

Leistungsmerkmale

- · Schnelles Ansprechverhalten
- Ausgezeichnete Langzeitstabilität
- Genauigkeit 0,5 / 0,3 K (TSic 206 / 306)
- Weiter Temperaturbereich -50 ... +150 °C
- Kleines Gehäuse TO92 / SO8
- Minimale Entwicklungskosten und –zeiten
- Einfache Integration

Typische Anwendungsgebiete

- Mess- und Regelungstechnik
- · Medizinische Anwendungen
- Temperaturüberwachung
- Batteriebetriebene Systeme
- Industrielle Messtechnik

Eigenschaften

Die TSIC™ Temperatursensoren zeichnen sich durch Ihre hohe Genauigkeit, das schnelle Ansprechverhalten und Ihr besondere Langzeitstabilität aus. Gegenüber anderen Halbleiter-Temperatursensoren bieten sie einen erweiterten Messbereich von –50 ... 150 °C mit einer Auflösung von 0,1 K.

Durch die digitale Schnittstelle ist der Anschluss an Mikrocontroller einfach möglich, ohne dass ein zusätzlicher Analog-Digitalwandler benötigt wird. Die Sensoren sind kalibriert, so dass keine weiteren Abgleicharbeiten durch den Gerätehersteller oder den Kunden mehr notwendig sind.

Diese innovativen Halbleitersensoren sind somit eine leistungsstarke und kosteneffektive Lösung für Temperaturmessungen in der industriellen Mess- und Regelungstechnik.

DATENBLATT

TSIC™ Digitale Halbleitertemperatursensoren TSIC 206 / 306



Digitaler Temperaturwert

Messbereich –50 +150 °C / -58 +302 °F						
Temp (°C)	Temp (°F)	Tsic 206 / 306				
-50	-58	(digital) 0x000				
-10	14	0x199				
0	32	0x200				
25	77	0x2FF				
60	140	0x465				
125	257	0x6FE				
150	302	0x7FF				

Absolute Grenzdaten

Parameter	Min	Max	Einheit
Betriebsspannung (V+)	-0,3	6,0	V
Spannung am Analog- ausgang I/O –Pins (V _{INA} , V _{OUTA})	-0,3	V _{DDA} + 0,3	V
Lagertemperaturbereich	-50	150	°C

Betriebsdaten

Parameter	Min	Тур	Max	Einheit
Betriebsspannung ¹	2,97	5,0	5,5	V
Versorgungsstrom (I_{V+}) @ V+ = 3,3 V, RT	30	45	80	μΑ
Umgebungstemperatur- bereich (T _{amb})	-50		150	°C
Ausgangskapazität (C _L)			15	nF
Externe Kapazität zwischen V+ und Gnd³ (C _{V+})	80	100	470	nF
Ausgangsleistungs- widerstand zwischen Signal und Gnd (or V+)	47			kΩ

 $^{\rm 1}\mbox{Betrieb}$ im Spannungsbereich von 2,7 ... 2,97 V ist mit reduzierter Genauigkeit möglich

³Der Anschluss des Abblockkondensators muss so nahe als möglich an den Anschlusspins des Bauteils erfolgen.

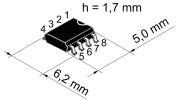
Temperaturgenauigkeit TSIC 206

Parameter	Min	Тур	Max	Einheit		
T1: +10 90 °C	-0,5		0,5	°C		
T2: -20 110 °C	-0,2	+0,4	0,95	°C		
T3: -50 150 °C	0	+0,9	2,0	°C		
Genauigkeitsangabe als 2σ Wert zuzüglich 1 digit						
Quantisierungsfehler						

Temperaturgenauigkeit TSIC 306

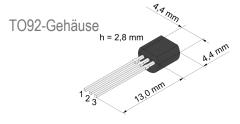
Parameter	Min	Тур	Max	Einheit
T1: +10 90 °C	-0,3	±0,3	0,3	°C
T2: -20 110 °C	-0,2	+0,3	0,95	°C
T3: -50 150 °C	0	+0,9	2,0	°C
Genauigkeitsangab fehler	e als 2o	Wert zu	züglich	1 digit Quantisierungs-

SO8-Gehäuse



SO8 Gehäuse (150 mil, Standard SMT Technologie, SOIC-8) nach IEC 191-2Q: Type 076E35 B

Pin Nr.	Name	Beschreibung
1	V+	Betriebsspannung (3 5,5 V)
2	Signal	Temperatur Ausgangssignal
4	Gnd	Ground
3, 5 - 8	TP/NC	Test Pin / NC (nicht verbinden)



kleines THT Gehäuse, TO92 ähnlich

Pin Nr.	Name	Beschreibung	
1	V+	Betriebsspannung (3 5,5 V)	
2	Signal	Temperatur Ausgangssignal	
3	Gnd	Ground	